

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 07147349
PUBLICATION DATE : 06-06-95

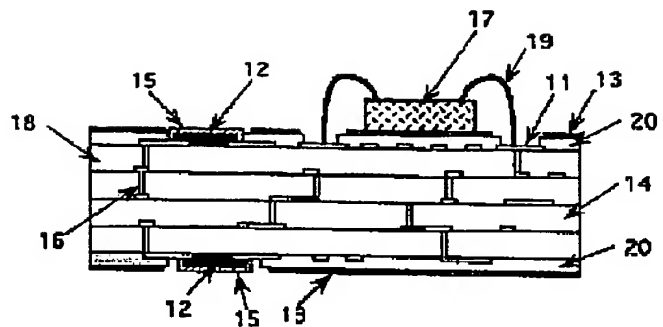
APPLICATION DATE : 24-11-93
APPLICATION NUMBER : 05315791

APPLICANT : HITACHI LTD;

INVENTOR : HASEGAWA MITSURU;

INT.CL. : H01L 23/12

TITLE : MULTILAYER CIRCUIT BOARD AND
ITS MANUFACTURE



ABSTRACT : PURPOSE: To provide a multilayer circuit board in which a low-resistance conductor interconnection is built, whose thermal resistance is low and which is used for a small and high-density hybrid IC.

CONSTITUTION: A multilayer circuit board has a structure wherein a conductor pattern 11 which forms a desired electric circuit is arranged on an insulator 18 and the conductor pattern 11 is connected electrically, by wires 19, to a heat-generating electronic circuit component 17. In the multilayer circuit board, a glass is used as the insulator 18, and a metallized layer 13, for discharging, which is electrically independent or which is connected to a grounding layer is formed in other surface parts excluding the conductor pattern arranged on the surface. The metallized layer is constituted preferably by using at least one out of Au, Ag, Cu, Pt and Pd as a main component, its ratio of area occupied to the surface area of the multilayer circuit board is preferably at least 20%, and its thickness is preferably 5 to 80 μ m.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-147349

(43) 公開日 平成7年(1995)6月6日

(51) Int.Cl.⁶

H 0 1 L 23/12

識別記号

庁内整理番号

F 1

技術表示箇所

H 0 1 L 23/ 12

E

H

審査請求 未請求 請求項の数 6 F D (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平5-315791

(22) 出願日 平成5年(1993)11月24日

(71) 出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72) 発明者 小川 敏夫

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

(72) 発明者 加藤 修治

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

(72) 発明者 神村 典孝

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

(74) 代理人 弁理士 中本 宏

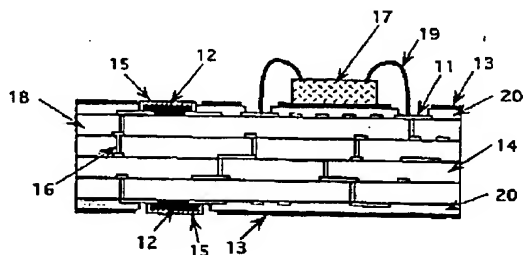
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 多層回路基板及びその製法

(57) 【要約】

【目的】 低抵抗性の導体配線を内蔵し、かつ低熱抵抗性の小型、高密度のハイブリッドIC用多層回路基板を提供すること。

【構成】 絶縁体18上に所望の電気回路を形成する導体パターン11が配置され、該導体パターン11と発熱性の電子回路部品17が電気的に接続19された構造を有する多層回路基板において、前記絶縁体18としてガラスを用い、表面に配置された該導体パターンを除く他の表面部分に、電気的に独立するか又はグランド層と接続して放電用のメタライズ層13を形成したものであり、前記メタライズ層は、Au、Ag、Cu、Pt、Pdのうちの少なくとも1つを主成分として構成され、前記多層回路基板の表面積に占める割合が少なくとも20%であり、厚さが5～80μmであるのがよい。





(2)

特開平7-147349

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁体上に所望の電気回路を形成する導体パターンが配置され、該導体パターンと発熱性の電子回路部品が電気的に接続された構造を有する多層回路基板において、前記絶縁体としてガラスを用い、表面に配置された該導体パターンを除く他の表面部分に、電気的に独立するか又はグランド層と接続して放電用のメタライズ層を形成したことを特徴とする多層回路基板。

【請求項2】 前記発熱性電子回路部品が、幾何学的に連続する前記メタライズ層上の一部に載置されていることを特徴とする請求項1記載の多層回路基板。

【請求項3】 前記メタライズ層は、前記多層回路基板の表面積に占める割合が少なくとも20%であることを特徴とする請求項1又は2記載の多層回路基板。

【請求項4】 前記メタライズ層が、Au、Ag、Cu、Pt、Pdのうちの少なくとも一つを主成分として構成されることを特徴とする請求項1、2又は3記載の多層回路基板。

【請求項5】 前記メタライズ層は、厚さが5~80μmであることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項記載の多層回路基板。

【請求項6】 ガラス材料で構成される絶縁体層に導体層が配置され、所望の電気的特性を実現する電子回路を有する多層電子回路基板の製法において、該電子回路と電気的に絶縁され、かつ該基板の表面に占める面積比が少なくとも20%の面積を有するメタライズ層を表層部に形成し、かつ該メタライズ層上に発熱性電子部品を載置することを特徴とする多層回路基板の製法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、民生用やコンピュータ用など電子工業に用いられる多層回路基板に係り、詳しくは低抵抗性導体配線を内蔵し、かつ熱放散性が良好な高密度多層回路基板及びその製法に関する。

【0002】

【従来の技術】近年のハイブリッドICは、より小型化、高密度化の要求から、グリーンシート上に電極パターンを印刷形成し、これらを積層、焼結することによって、もしくは、スクリーン印刷の繰返しによって多層化し、焼結することによって、基板内部に配線パターンを持つセラミック多層配線基板が用いられてきた。その基板を大別すると次の二つがある。その一つとして、例えば、特公平3-78798号公報の従来技術として記載されるように、WやMoを配線導体として使用し、1500~1600℃の高い温度で同時焼成するセラミックス多層基板がある。

【0003】他の一つとして、例えば、特開昭63-244899号公報に開示されるように、通常1000℃以下の比較的低い温度で絶縁体の焼結ができる低温焼結性セラミックス基板がある。上記の高温で焼成される基

2

板は、導体の抵抗率が大きく、高周波用回路への適用に難があると共に、配線抵抗が大きくなってしまいうので微細配線化による回路の高密度化ができないという欠点があった。

【0004】一方、低温焼結性の基板では、焼成温度が低いので、同時焼成する内蔵配線用導体材料として、Au、Ag、Cuなどのいわゆる低抵抗性導体材料が使用できる。その為、前述の導体抵抗率に関する問題点は解決できる。しかしながら、この種低温焼結性基板には絶縁材料として通常ガラスが使用される。この低温焼結性ガラスは、例えばアルミナ基板に比較して熱伝導性が極めて低い。そのため発熱性の電子部品、例えば消費電力の大きいLSIチップなどを搭載すると基板の温度が上昇しやすく、回路としての所望の特性を発揮しにくい。高密度化された基板では発熱密度が高くなり、この問題がいつそう顕著である。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】上記したように、低抵抗性導体配線を内蔵し、表面に発熱性電子回路を配置した多層回路基板では充分な放熱特性を得にくいという問題があった。本発明はこうした問題点を解決し、かつ低抵抗性の導体配線を内蔵した、小型かつ高密度の、高周波用途を含む電子工業用多層回路基板とその製法を提供することを課題とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明では、絶縁体上に所望の電気回路を形成する導体パターンが配置され、該導体パターンと発熱性の電子回路部品が電気的に接続された構造を有する多層回路基板において、前記絶縁体としてガラスを用い、表面に配置された該導体パターンを除く他の表面部分に、電気的に独立するか又はグランド層と接続して放電用のメタライズ層を形成することとしたものである。

【0007】上記多層回路基板において、発熱性電子回路部品は、幾何学的に連続する前記メタライズ層上の一部に載置されているのがよく、また、メタライズ層は、前記多層回路基板の表面積に占める割合が少なくとも20%であり、厚さが5~80μmであるのがよく、その材質は、Au、Ag、Cu、Pt、Pdのうちの少なくとも一つを主成分として構成されるのがよい。

【0008】また、上記他の課題を解決するために、本発明では、ガラス材料で構成される絶縁体層に導体層が配置され、所望の電気的特性を実現する電子回路を有する多層電子回路基板の製法において、該電子回路と電気的に絶縁され、かつ該基板の表面に占める面積比が少なくとも20%の面積を有するメタライズ層を表層部に形成し、かつ該メタライズ層上に発熱性電子部品を載置することとしたものである。

【0009】上記のように、本発明では、絶縁性材料を積層した基板の表層部に、Au、Ag、Cuなどの高熱

伝導性の、放熱用メタライズ層を、所定の電気回路を構成する導体パターンとは電気的に絶縁して配置することにより、基板からの熱放散を容易ならしめ、高精度の電気的特性を有する、小型かつ高密度の、高周波用途を含む電子工業用多層回路基板を実現するものである。

【0010】前記絶縁性材料は前述したように通常、軟化点の低い低温焼結性ガラスで構成され、配線導体と同時に焼成される。前記表層部の放熱用メタライズ層の形成にあたっては、次の二つの方法がある。一つは、表層回路パターンが存在しない基板表面部分に、前記放熱用のメタライズ層を直接形成する方法である。他の一つは、表層回路パターン上にまず被覆用の絶縁層を形成し、その上に該メタライズ層を形成する方法である。前者は簡便法であり、後者はパターン設計上の自由度が高く、放熱効果もより大きい。本発明による上記放熱用メタライズ層を積層回路基板の表面に形成することにより、基板からの熱放散が容易となり、高精度の電気的特性を有し、かつ低抵抗性導体配線を内蔵する高密度の多層回路基板が得られる。

【0011】例えば、本発明による多層回路基板の内層用絶縁体材料として、ほうけい酸鉛系ガラスを用いることによって、850℃程度の温度でも焼結できるので、低抵抗性導体配線の内蔵が可能となり、その表層部にAu、Ag、Cuなどの高熱伝導性の材料による前記放熱用メタライズ層を設けることにより、放熱特性の向上を図ることができる。そして、本発明で得られる多層回路基板は、表層部に放熱用メタライズ層を包含し、かつ低抵抗内蔵導体配線を有しているため、携帯用のカメラ、ビデオ型ビデオ装置並びに信号を高速化した通信電子機器やコンピュータなどを構成する電子回路基板として有効活用できる。

【0012】

【作用】本発明は、低抵抗性の導体配線を内蔵し、その表面に放熱用メタライズ層を形成して発熱性電子部品を配置する構造である。従って、該電子回路で発生した熱が局所に停滞する傾向が改善され、大面積に分散して、大気中に効率良く放熱することができる。このことは、熱伝導率は、絶縁体として用いるガラスが2W/mkであるのに対し、本発明で用いる放電用メタライズ層が420W/mkであることによる。ちなみに、熱伝導率はAlNが200W/mk、BeOが300W/mkであり、これらを絶縁体として用いる場合はメタライズ層は必要がない。従って、回路の高密度化にも有効である。また、基板表層部に形成された該メタライズ層は不要輻射電波を吸収、低減する作用がある。

【0013】

【実施例】以下、本発明を実施例により具体的に説明する。

実施例1

図1及び図2に本発明の一実施例を示す。図1では本発

明による多層回路基板の発熱性電子部品を含む部分断面図を示し、図2にはその平面図を示している。上記多層回路基板は次のようにして製造する。まず、ほうけい酸鉛ガラス粉と耐熱性フリットとしてのアルミナ粉末に、ポリビニルブチラール等の有機溶媒を加えてかくはんし、泥しよう化状態にする。この泥しようを、ドクターブレードを用いたキャストイング成膜法によってグリーンシートとし、未焼成の電気絶縁性グリーンシートを複数枚形成する。

【0014】次に、前記グリーンシートをステンレス等から成る金型を入れ、外形と複数の孔部（ビアホール）とを同時にパンチングして形成する。このグリーンシート上に、通常3μmΩ-cmより低い抵抗率が得られる銀を主成分とする導体ペーストを、スクリーン印刷法によって塗布して、表層パターン11もしくは内層導体配線14を形成すると共にビアホール16を充填する。同様に作成した複数のグリーンシートを用いて順次積み重ねる。次いで、熱プレス機等を用いて温度120℃、圧力200kg/cm²の条件で上下面から熱圧着して、グリーンシートの積層体を得る。

【0015】この成形体を、空气中、温度350℃で約1時間脱脂した後、やはり空气中で800-1000℃、約10分の焼成によって、低抵抗性の内層導体配線部14を低温焼結性のガラスセラミック組成部18に内蔵した多層回路基盤を得る。この基板上の、チップ部品もしくは受動素子等を配置する部分を除く表層部に、被覆用絶縁層20を形成し、その上に導体ペーストを用いてスクリーン印刷-乾燥後焼成して放熱用メタライズ層13を形成する。さらに、この基板上の所定位置にRuO₂を主体とする抵抗体12をスクリーン印刷によって形成した後、乾燥-焼成して厚膜抵抗体を構成する。通常は、さらにこの抵抗体上にガラスペーストを印刷-乾燥し、600℃以下の低い温度で焼成して、保護ガラス皮膜15を形成して、多層回路基板とする。この基板上に発熱性のLSIチップを含む電子部品17を搭載し、必要に応じてワイヤボンディング19などの手段によって電気的に接続し、多層回路基板が完成する。

【0016】本実施例では、LSIチップの接続方法として、ワイヤボンディング19を用いた例を示したが、他の方法例えば、TCP（Tape Carrier Package）もしくはCCB（Chip Carrier Bonding）もしくはLCC（Leadless Chip Carrier）などの手段であってもよい。また、内層の導体材料として、Agを用いた例について詳細に記してきたが、Au、Pt、Pd及びこれらの合金についても同様に使用可能である。Cuについても、不活性ガス中で焼成することにより同様に適用可能である。

【0017】実施例2

実施例1と同様の手順によって、低抵抗性の内層導体配線部14を低温焼結性のガラスセラミック組成部18に

内蔵した多層回路基板を得る。この基板上の、LSIチップを接続する表層部の全面に、無電解めっき法によって厚さ約2 μ mの銅皮膜を形成する。さらに、電解めっき法により該銅皮膜の膜厚を約25 μ mまで厚くする。この皮膜表面に感光性レジン塗布してパターンニングするいわゆるホトレジスト法を用いて所望の形状を有する放熱用メタライズ層13を含む、層数5層、50mm角、厚さ0.8mmの、多層基板を作製した。このように、放熱用メタライズ層13を、めっき法によって形成することで、良好な該皮膜の膜厚制御性及び表面平滑性が得られる。

【0018】実施例3

実施例1と同様の手順によって、低抵抗性の内層導体配線部14を低温焼結性のガラスセラミック組成部18に内蔵した多層回路基板を得る。この基板上の、LSIチップを接続する表層部に、直接銅箔を接合する、いわゆるダイレクトボンディング法を用いることによりメタライズ層13を形成する。この方法は、銅箔の表面に生成する酸化銅と、セラミック基板を形成する酸化物を化学反応によって結合するもので、通常、接合プロセス温度は酸化銅の共晶点(1065℃)以上、銅の融点(1083℃)以下である。ここで使用する銅箔は、表面の全面を被覆するものでもよく、あるいは予め任意にパターンニングされたものでもよい。前者の場合には実施例2と同様に、ホトレジスト法を用いて所望の形状を有する放熱用メタライズ層13を形成する。

【0019】実施例4

実施例1と同様の手順によって、導体層数5層、50mm角、厚さ0.8mmの、放熱用メタライズ層13を含む多層基板を作製した。この時、放熱用メタライズ層13の占める面積率を、片側の基板表面積に対して7.8%、15%、30%、50%、75%の5段階に調節してパターン形成し、その膜厚はいずれも15 μ m一定とした。その基板中央部に11.6mm角、消費電力1.7WのLSI17を1個搭載し、ワイヤボンディング19によって基板の所定部位に接続した。

【0020】これら5種類の基板について、それぞれLSIに定格電力を付加し、基板表面に風速2m/秒の送風条件下でLSI表面の定常温度を測定した。その結果、メタライズ層13の面積率が低い順に温度が高く、それぞれ77.5℃、75℃、68.5℃、48℃、41.5℃であった。この結果より、面積率20%以下では熱放散効果が不十分と言え、実用的にはそれ以上、すなわち少なくとも20%の面積率を有する放熱用メタライズ層13を形成することが好ましい。

【0021】実施例5

実施例2と同様の手順によって放熱用メタライズ層の基板全体に対する面積率50%を有するテストサンプルを作製した。この時、スクリーン印刷条件を変えることによってこのメタライズ層の膜厚を3 μ m-200 μ mの

範囲で10段階に調節した。完成したサンプルを実施例2と同様に放熱効果を評価した。その結果膜厚5 μ m以下では熱放散効果が不十分であった。一方、膜厚が80 μ m以上ではメタライズ層の強度がセラミック基板との比較で相対的に上昇し、基板自体が変形してしまうという現象が有り、好ましくない。従って、セラミック基板の強度及び放熱効果の両面を考慮してメタライズ層の膜厚を設定する必要がある。本実施例の条件では膜厚5 μ m-80 μ mが選定可能な適正膜厚範囲といえる。

【0022】実施例6

本発明の一応用例を図3に示す。図は通信用電子交換機システムの構成模式図を示している。発熱性のLSIチップ素子34を含む本発明による回路モジュール35を構成する。回路モジュール35を搭載した、多層プリント基板によるマザーボード33を筐体32に装着して一連の交換機回路システムを構成する。筐体32の上下部位に設置したファン31による上昇方向の空気流で、回路から発生する熱は系外に排出される。

【0023】本実施例では空気流による冷却方式の例を示したが、例えばこれが水冷式もしくはヒートパイプを用いて、回路モジュール35に形成した放熱用メタライズ層13から直接冷却する方式などにより、さらに高い冷却効果が期待できる。以上の実施例は、いずれもセラミック多層回路基板の例を示したが、例えば絶縁体材料としてガラスエポキシを用いたプリント配線基板などにも、本発明の適用が可能である。また、放熱用メタライズ層の形成手段として厚膜による例及びめっきもしくは銅箔の直接接合の例を示したが、これらを複合化した手段の適用も可能である。

【0024】

【発明の効果】本発明によれば、低抵抗性導体配線の内蔵し、かつ低熱抵抗性多層回路基板とすることができ、導体パターンの微細配線化が可能となることに加え、基板からの放熱特性が良好であるので、電子回路の小型化もしくは高密度化に貢献でき、特に高速化又は高周波化回路に有効使用できる。さらに、不要輻射電波によるノイズを低減する効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例による多層回路基板の断面構成図。

【図2】図1の多層回路基板の平面構成図。

【図3】本発明を用いる通信用電子交換機システムの構成模式図。

【符号の説明】

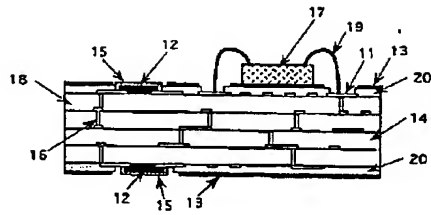
11：表層導体パターン、12：膜厚抵抗体、13：放熱用メタライズ層、14：内層導体、15：保護ガラス皮膜、16：ビア、17：発熱性電子部品、18：絶縁体ガラスセラミック組成部、19：ボンディングワイヤ、20：被覆用絶縁層、31：ファン、32：筐体、33：マザーボード、34：発熱性LSIチップ、3

(5)

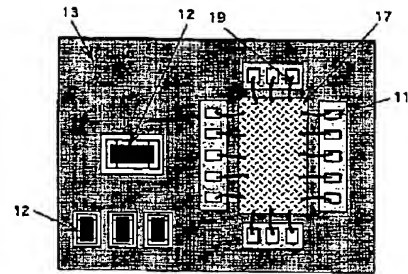
特開平7-147349

5:回路モジュール、36:リードピン

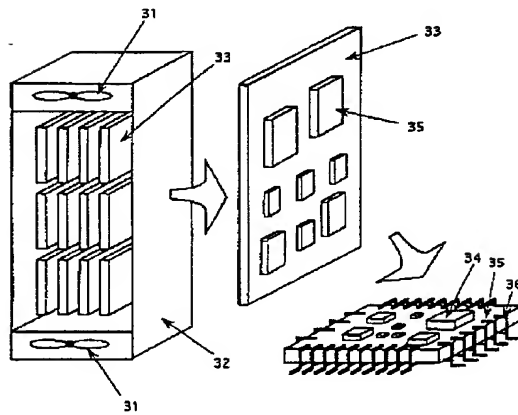
【図1】



【図2】



【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 長谷川 満
茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株
式会社日立製作所日立研究所内

11